RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	1

1 適用範圍:

- 1.1 本規範適用於RTW系列低阻完全無鉛、無鹵素符合RoHS條款的寬電極厚膜晶片電阻
- 1.2 該產品應用於一般電子用途。

2 型別名稱:

(例)

RTW	<u>ٿ</u>	<u>6</u>	<u>R240</u>	ئے	
型別	尺寸		電阻值	容差	包裝型式(請參閱 IE-SP-054)
寬電極低阻厚膜 晶片電阻器	05(0508) 06(0612) 18(1218) 20(1020) 25(1225)	4-碼	EX.: 0.24Ω=R240 0.05Ω=R050	F=± 1% J=± 5%	TP: 4 mm Pitch Carrier Tape 5000 pcs P2: 4 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs P3: 4 mm Pitch Carrier Tape 15000 pcs P4: 4 mm Pitch Carrier Tape 20000 pcs TE: 4 mm Pitch Carrier Tape 4000 pcs.

3 規格表:

型別	額定 功率 70 ℃	最高 額定 電流	最高 過負額 電流	T.C.R (ppm/°C)	阻值範圍 F(±1%)、J((±5%) E-24、E-96
				±800	$10m\Omega \le R < 30m\Omega$
RTW05	$\frac{1}{3}$ W	5.77A	14.43A	±400	30 m Ω \leq R $<$ 56 m Ω
(0508)	3 **	3.77A	14.43/	±200	$56m\Omega\!\leq\!R\!<\!180m\Omega$
				±200	$180m\Omega \leq R < 1\Omega$
				±2000	$10m\Omega \le R < 30m\Omega$
RTW06	1W	10A	25A	±1000	30 m Ω \leq R $< 56m\Omega$
(0612)	1 V V	TOA	25A	±700	$56m\Omega\!\leq\!R\!<\!180m\Omega$
				±250	$180m\Omega \leq R < 1\Omega$
	1W			±2000	$10m\Omega \le R < 30m\Omega$
RTW18		10A	25A	±1000	$30m\Omega \le R < 56m\Omega$
(1218)				±700	$56m\Omega \le R < 180m\Omega$
				±250	$180m\Omega \le R < 1\Omega$
				±800	$10m\Omega \le R < 30m\Omega$
RTW20	1W	10A	25A	±400	$30m\Omega \leq R < 56m\Omega$
(1020)	1 V V	TOA	25A	±200	$56m\Omega \le R < 180m\Omega$
				±200	$180m\Omega \leq R < 1\Omega$
		·		±800	$10m\Omega \le R < 30m\Omega$
RTW25	2W	14.14A	35.35A	±400	$30m\Omega \le R < 56m\Omega$
(1225)	∠٧٧	14.14A	30.35A	±200	$56m\Omega \le R < 180m\Omega$
				±200	$180m\Omega \le R < 1\Omega$
	使月	用溫度範圍	-		-55℃ ~ +155℃

	IE		QA	備註
制訂 ナ サ サ	審查	核准	會簽してあれ	非發行管制文件
生的化	13 / J	73.4	27/2000	自行注意版本更新
	- 3	AZ		非經允許,禁止自行影印文件 Series No.

章DATA Center.

.60

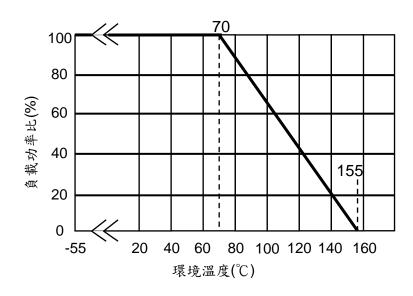
RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	2

3.1 功率衰減曲線:

使用溫度範圍:-55 ~ 155 ℃

周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下圖曲線予以修定之。



3.2 額定電流:

額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。

可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,則以最高額定電流為其 額定電流。

$$I = \sqrt{P/R}$$

|= 額定電流(A)

P= 額定功率(W)

R= 公稱阻值(Ω)

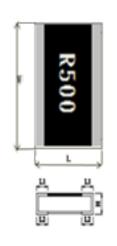
備	非白	發行	行注	管意	版	制木	文重	件新	發行管制章DATA Center.
註	非	三經允	上許,			7 行影	印文		Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	3

4 尺寸:

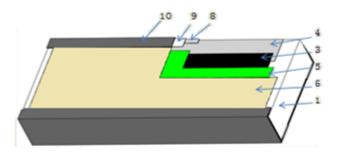
Unit:mm



Туре	Dimension SizeCode	L	W	Н	L1	L2
RTW05	0508	1.20±0.10	2.00±0.10	0.50±0.10	0.20±0.10	0.20±0.15
RTW06	0612	1.60±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.35±0.15	0.25±0.15
RTW18	1218	3.10±0.10	4.60±0.20	0.55±0.10	0.45±0.25	0.40±0.20
RTW20	1020	2.50±0.20	5.00±0.20	0.55±0.10	0.25±0.20	0.90±0.20
RTW25	1225	3.20±0.20	6.40±0.20	0.55±0.10	0.45±0.20	0.75±0.20

5 結構圖:

Bottom side



Top Side



1	陶瓷基板	Ceramic substrate	6	2nd 保護層	2nd Protective coating
2	正面內部電極	1st Top inner electrode	7	G2+MK層層	G2 layer+Marking
3	電阻層	Resistive layer	8	側面內部電極	Terminal inner electrode
4	1 st 背面內部電極	Bottom inner electrode	9	Ni 層電鍍	Ni plating
5	1nd 保護層	1st Protective coating	10	Sn 層電鍍	Sn plating

備	非自	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			文更	件新	
註	非	三經允		行影	印文	<u></u> 件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	4

6 信賴性試驗項目:

6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test)

Item	Conditions	Specifications規格
項目	條件	Resistors
Temperature Coefficient of Resistance 溫度係數	TCR (ppm / $^{\circ}$ C) = $\frac{(R2-R1)}{R^{1}(72-71)}$ ×106 R1:室温下量測之阻值(Ω) R2:-55 $^{\circ}$ C或+125 $^{\circ}$ C下量測之阻值(Ω) T1:室温之温度($^{\circ}$ C) T2:-55 $^{\circ}$ C或+125 $^{\circ}$ 之温度($^{\circ}$ C)。	參考3.規格表
Short Time Overload 短時間過負荷	RTW05/18/20施加2.5倍的額定電流5秒,RTW06施加2倍的額定電流5秒,RTW25施加2.5倍的額定電流2秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變化率。(額定電流值請參考 3.規格表)依據 JIS-C5201-1 4.13	1%、5%:∆R=±2.0%
Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓	將晶片電阻置於治具上,在正、負極施加VAC (參考下列) RTW05(0508) 用 300VAC 1 分鐘 RTW06(0612) 用 400VAC 1 分鐘 RTW18(1218)用 500VAC 1 分鐘 RTW20(1020) 用 500VAC 1 分鐘 RTW25(1225) 用 500VAC 1 分鐘 K據 JIS-C5201-1 4.7	無短路或燒毀現象。
Intermittent Overload 断續過負荷	置於恆溫箱中,施加2.5倍額定電流,1秒ON,25秒OFF,計10000+400/-0次後取出靜置60分鐘後量測阻值變化量。依據 JIS-C5201-1 4.13	∆R=±5.0%

備	非發行管制文件自行注意版本更新	發行管制章DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	5

6.2 機械性能試驗(Mechanical Performance Test)

Item	Conditions	Specifications規格
項目	條件	Resistors
月 月 月 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	前處理:將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、 濕度100%及氣壓1.22×10 ⁵ pa的飽和條件下進行4小時的老 化測試,取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法:將電阻浸於235±5℃之爐中2秒後取出置於顯微 鏡下觀察焊錫面積。 依據 JIS-C5201-1 4.17	
Soldering Heat 抗焊錫熱	浸於260+5/-0℃之錫爐中10+1/-0秒,取出靜置60分鐘以上,再量測阻值變化率。 ◎測試項目二(焊錫爐測試): 浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 ◎測試項目三(電烙鐵試驗): 加熱溫度:350±10℃	試驗項目一: (1).阻值變化率
	②彎折性測試: 將晶片電阻焊於彎折性測試板中,置於彎折測試機上,在測試板中央施力下壓,於負荷下量測阻值變化率. D:RTW05、RTW06=3mm RTW18、RTW20、RTW25=2mm Resistor Testing circuit bound Chilp resistor (Arrount of band) (依據 JIS-C5201-1 4.33	ΔR%=±2.0%

住	崩	非發行管制文件	發行管制章DATA Center.
		自行注意版本更新	
言	主	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	6

6.3 環境試驗(Environmental Test)

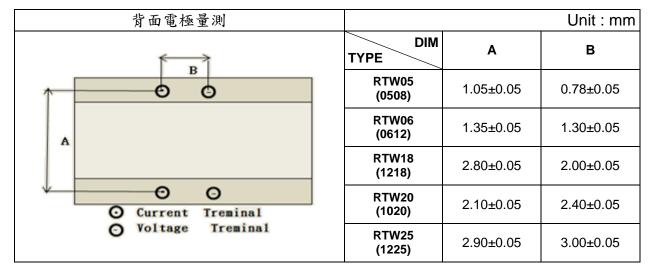
Item	Conditions	Specifications規格
項目	條件	Resistors
to Dry Heat 耐熱性試驗	置於155±5℃之烤箱中1000+48/-0 hrs,取出靜置1 hr以上再量測阻值變化率。 PS:RTW0508、RTW0612置於125±3℃中。 依據 JIS-C5201-1 4.25	1% 、5%:∆R=±2.0%
	+125℃ 15分鐘,共計循環300次後取出,靜置60分鐘再量 測阻值變化率。 測試條件	1% 、 5%:∆R=±2.0%
Loading Life in Moisture 耐濕負荷	置於溫度40±2℃相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中,並施加額定電流,90分鐘ON,30分鐘OFF,共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.24	1% 、 5%:∆R=±3.0%
Load Life 負荷壽命	置於70±2℃之烤箱中施加額定電流,90分鐘ON,30分鐘OFF,共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。依據 JIS-C5201-1 4.25	

偖	非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新	發行管制章DATA Center.
喜	W W I I I X II	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	7

7 阻值測試包裝標準量測位置:



8 鍍層厚度:

8.1 鎳層厚度:≧2µm

8.2 純錫:≧3µm

8.3 電鍍純錫為霧錫

備註	١, ,,	· 行· 计·		制	文更	件		發行管制章DATA Centel
	自行	注	意 版	<u> </u>		新		
註	非經	允許,	禁止自	行影	印文	件		Series No. 60

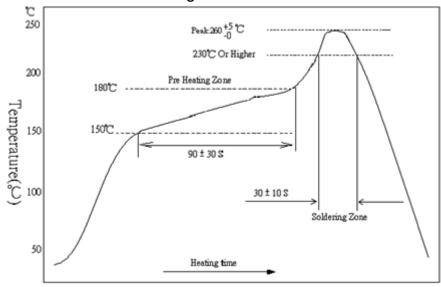
RAI	_EC
BŦ	詮

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	8

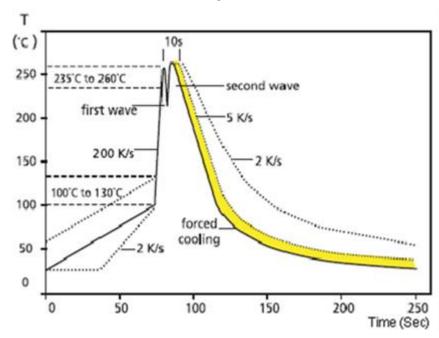
9 技術應用說明(此為建議,請客戶使用時依實際應用作調整)

- 9.1 建議焊錫條件:
 - 9.1.1 Lead Free IR Reflow Soldering Profile



備註:零件最高耐溫260+5/-0 ℃,10秒。

9.1.2 Lead Free Double-Wave Soldering Profile



9.1.3烙鐵焊錫方法:350±10°C,3秒之內。

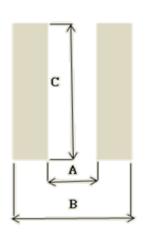
備	非發行管制文件	發行管制章DATA Center.
	自行注意版本更新	
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	9

9.2 建議Land Pattern Design (For Reflow Soldering):

當元件被焊接時,焊接後的電阻值根據焊接區域的大小和焊接量的不同而稍有變化。設計電路時,有必要考慮其電阻值降低或增加的影響。



			Unit:mm
TYPE DIM	Α	В	С
RTW05 (0508)	0.6	2.2	2.3
RTW06 (0612)	0.7	2.6	3.5
RTW18 (1218)	1.9	4.1	4.9
RTW20 (1020)	0.5	3.5	5.3
RTW25 (1225)	1.3	4.2	6.4

9.3 使用環境注意事項:

此規格產品為一般電子用途,RALEC將不為任何使用在特殊環境下,使用此規格產品導致之損害、費用或損失負責,如有其他應用需與RALEC進行確認是否適用。

若客戶端有意於特殊環境或狀態下使用本公司產品(包括但不限於如下所示),則需針對下列或 其他運用環境各別承認產品特性及信賴性。

- (a) 運用於高溫高濕之環境。
- (b) 於接觸海風或運用於其他腐蝕性氣體之環境: CI2、H2S、NH3、SO2及NO2。
- (C) 於非驗證過液體中使用,包括水、油、化學品及有機溶劑。
- (d) 使用非驗證過之樹脂或其他塗層材料來封合或塗層本公司產品。
- (e) 於焊錫後之清洗,需使用水溶性清潔劑清洗殘留於產品助焊劑,縱然使用免洗助焊劑仍建 議清洗。

9.4 暫態過載注意事項:

本產品可能對於暫態過載而導致產品之功能喪失,請注意您的製造過程和保存,避免發生高於 產品規格之暫態電流施加在產品上。

備	非發行管制文件	發行管制章DATA Center.
	自行注意版本更新	00
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	10

9.5 作業及處理注意事項:

- (a) 作業時需確保電阻邊緣及保護層免於機械應力破壞。
- (b) 印刷電路板 (PCB) 分開或固定在支撐體上時應小心操作,因為印刷電路板 (PCB) 安裝的彎曲會對電阻器造成機械應力。
- (c) 電阻需於規格中額定功率範圍內使用,尤其當功率超出額定值時,將會負載在電阻上, 有可能因溫度上升造成機器損害。
- (d) 若電阻將可能接受大量負載(脈衝波)衝擊時,必須於使用前設置作業環境。
- (e) 使用該產品時請在貴司實裝狀態下評估及確認,充分考慮故障安全設計,確保系統上的安全性。

10 儲存及搬運條件:

- 10.1 在儲存環境25±5°C、60±15%之條件下可儲存二年。
- 10.2 存儲時請避免如下惡劣環境,以免影響產品性能及焊錫連接性:海風、CI2、H2S、NH3、SO2及NO2等腐蝕性氣體的場所,陽光直射、結露場所。
- 10.3 產品搬運、存儲時請保證箱體的正確朝向,嚴禁摔落、擠壓箱體,否則可能造成產品 電極或本體受損。

11 電子資訊產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸)



12 附件:

12.1 文件修訂記錄表 (QA-QR-027)

備註	非發行管制文件自行注意版本更新	發行管制章DATA Center.
註	非經允許,禁止自行影印文件	Series No. 60

RTW系列低阻厚膜晶片電阻器規格標準書

文件編號	IE-SP-136
版本日期	2019/09/09
頁次	11

法律免责聲明

RALEC 及其經銷商與代理商(以下統稱"RALEC")不因任何產品相關資訊(包括但不限於產品規格、資料、圖片和圖表)中包含的任何錯誤、不正確或不完整,而承擔任何責任。RALEC 可能隨時對產品相關資訊進行更改、修訂或改善,恕不另行通知。

RALEC 對於其產品使用於特殊目的之適用性或其任何產品的持續生產不為任何承諾、保證及/或擔保。在法律准許的最大程度內,RALEC不承擔任何下述之責任:(i)因應用或使用任何 RALEC 產品而產生之任何及所有責任,(ii)任何及所有責任,包括但不限於因 RALEC 產品所造成或與 RALEC 產品相關的利潤損失或是直接損害、間接損害、特別損害、懲罰性損害、衍生性損害或 附帶性損害,及(iii)任何及所有默示保證,包括產品適用於特殊用途、非侵權、及適銷性。

RALEC 將此產品定義為一般電子用途,不適用於任何車用電子、醫療救生或維生設備,亦不適用於當 RALEC 產品故障時,可能造成人員傷亡之任何應用上。RALEC 所提供的任何及所有的關於產品應用上的技術建議,均為無償提供,RALEC 對於採用該等技術建議及可獲取的結果,不承擔任何義務及責任,採用該等建議之所有風險,概由買方承擔。買方將 RALEC 產品使用於與其他材料或原料結合、或實施於其任何製程中之組合,所產生的所有風險及責任,概由買方承擔,不論 RALEC 對於產品的使用給予任何口頭或書面的技術説明、建議或其他。

此處所提供之資訊僅為說明產品規格,產品未變更時,RALEC 保有修改此內容不另行通知之所有權利,任何產品變更將會以 ECN 公布。

備註	非自	發	 -	制本	文更	件新	發行管制章DATA Center.
註		經允		· 行影	印文	·	Series No. 60